

SFE 235



Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor für den Betrieb in Basisschaltung.

Für den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand R_{thja}

auf Leiterplatte (Cevaust $\geq 0,4 \text{ cm}^2$) $\leq 480 \text{ K/W}$

auf Keramik $8 \times 10 \times 0,7 \text{ mm}$ $\leq 420 \text{ K/W}$

Grenzwerte

U_{CBO}	40 V
U_{CEO}	25 V
U_{EBO}	4 V
I_C	25 mA
P_{tot} (bei $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$)	300 mW
ϑ_j	150 °C
ϑ_a	-55 ... +125 °C

Statische Kennwerte

(bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 40 \text{ V}$)	$\leq 0,5 \mu\text{A}$
$U_{(BR)CEO}^{1)}$	(bei $I_C = 1 \text{ mA}$)	$\leq 25 \text{ V}$
$U_{(BR)EBO}$	(bei $I_E = 10 \mu\text{A}$)	$\leq 4 \text{ V}$
I_B	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$)	$\leq 35 \mu\text{A}$

Dynamische Kennwerte (bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

$-C_{12}$	(bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 10,7 \text{ MHz}$)	$\leq 35 \text{ pF}$
F	(bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$),	
$Y_G = (5 - j 3,3) \text{ mS}$		$\leq 4 \text{ dB}$
$f_{y_{21b}}$	(bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$)	typ. 750 MHz

¹⁾ Messung erfolgt impulsmäßig